



SEMICONDUCTOR

TECHNICAL DATA

東芝トランジスタ TOSHIBA TRANSISTOR

2SC2036

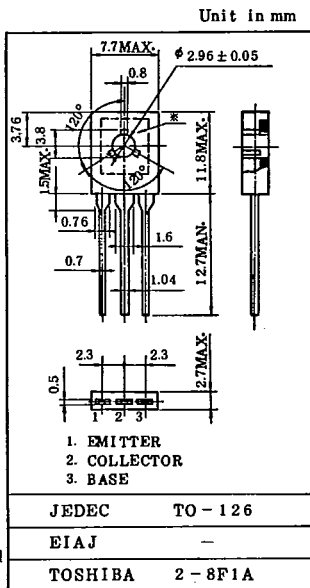
SILICON NPN EPITAXIAL TYPE(PCT PROCESS)★

- 27MHz 高周波電力増幅用
- 27MHz RF Power Amplifier Applications
- 1Wトランシーバ送信部出力用および4Wトランシーバ励振用として適しています。
- Recommended for 1W Mobile Radio Output Stage and Driver Stage of 4W Transmitter

最大定格 MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V _{CB0}	80	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CER}	80	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EBO}	5	V
コレクタ電流	I _C	1	A
エミッタ電流	I _E	-1	A
コレクタ損失	P _C	1	W
接合温度	T _j	150	°C
保存温度	T _{stg}	-55~150	°C

注：※点線内のメタルはコレクタに接続されています。
The inside metal of dotted line is connected to collector lead.



電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

アクセサリはAC46を適用
MOUNTING KIT No.AC46C

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタシャ断電流	I _{CBO}	V _{CB} =60V, I _E =0	—	—	0.1	μA
コレクタシャ断電流	I _{CER}	V _{CE} =80V, R _{BE} =220Ω	—	—	0.1	mA
エミッタシャ断電流	I _{EBO}	V _{EB} =5V, I _C =0	—	—	0.1	μA
直 流 電 流 増 幅 率	h _{FE}	V _{CE} =2V, I _C =150mA	100	—	—	—
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C =500mA, I _B =20mA	—	—	0.7	V
ベース・エミッタ間電圧	V _{BE}	V _{CE} =2V, I _C =500mA	—	0.9	—	V
トランジション周波数	f _T	V _{CE} =10V, I _C =100mA	—	150	—	MHz
コレクタ出力容量	C _{ob}	V _{CB} =10V, I _E =0, f=1MHz	—	—	—	pF

★PCT技術により製造されています。

Produced by Perfect Crystal Device Technology.



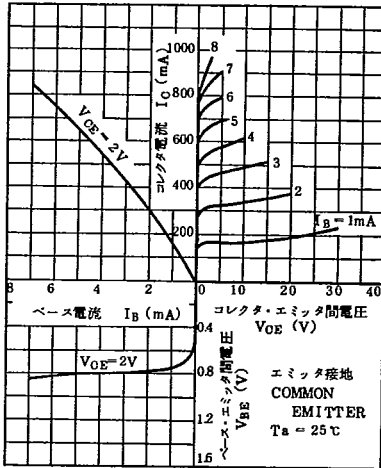
東芝

SEMICONDUCTOR

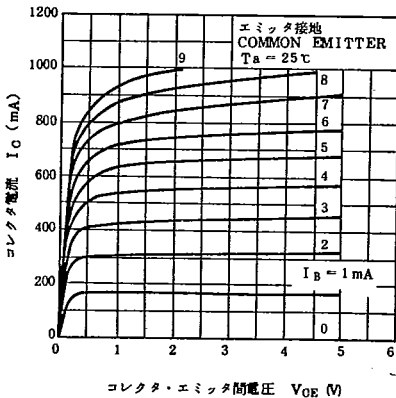
TECHNICAL DATA

2SC2036

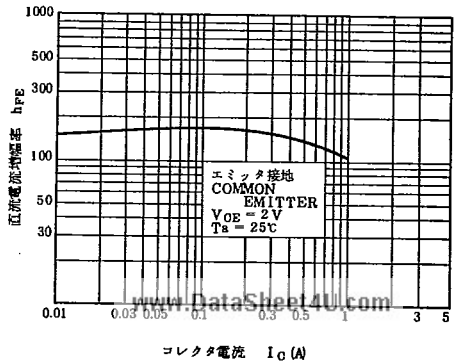
STATIC CHARACTERISTICS



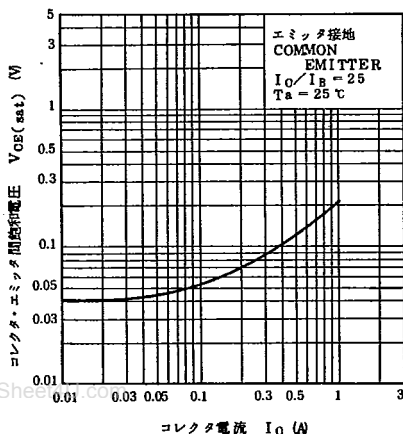
$I_C - V_{CE}$



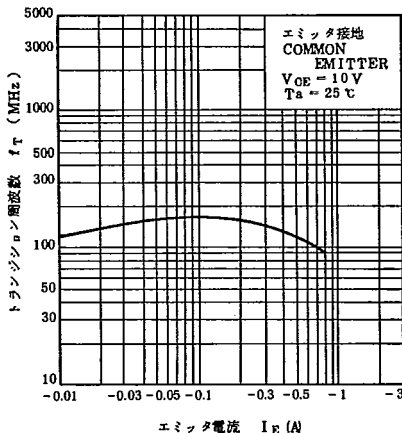
$h_{FE} - I_C$



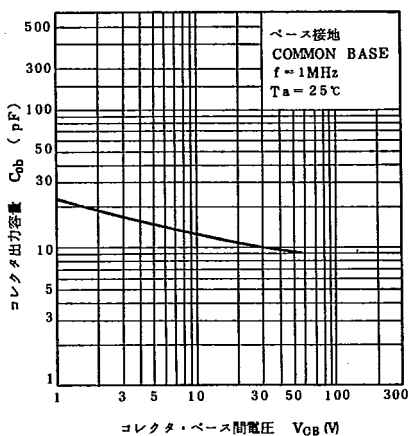
$V_{CE(sat)} - I_C$



$f_T - I_E$



$C_{ob} - V_{CB}$



$P_C - T_a$

